

لَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ يُخْلِدُ
إِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

۱۷۱۸



دانشکده رتبه

دانشکده علوم - گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته فیزیک گرایش حالت جامد

عنوان پایان نامه :

خواص مغناطیسی رادیکال های آزاد آلی با برهم کنش

آنتی فرومغناطیسی

اساتید راهنما :

۱۳۸۷ / ۱۷ / ۱۰

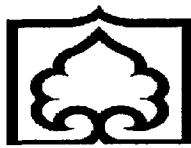
دکتر یوسفعلی عابدینی - دکتر جواد بداق جمالی

نگارنده : سمیه زارعی

۱۳۸۷ / ۱۷ / ۱۰

تیر ۱۳۸۷

۱۰۸۷۱۸



دانشگاه زنجان

دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته فیزیک گرایش حالت جامد

عنوان پایان نامه :

خواص مغناطیسی رادیکال های آزاد آلی با برهم کنش آنتی فرومغناطیسی

اساتید راهنما :

دکتر یوسفعلی عابدینی

دکتر جواد بداق جمالی

نگارنده :

سمیه زارعی

تیر ۱۳۸۷

شماره: ۸۵۱۲ تاریخ
تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۷

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم سمهیه زارعی رشته فیزیک گرایش حالت جامد
تحت عنوان: خواص مغناطیسی رادیکال های آزاد آلی با برهم کنش آنتی فرو مغناطیسی

در تاریخ ۱۴/۵/۸۷ با حضور هیأت محترم داوران در دانشگاه زنجان برگزار گردید و نظر هیأت داوران بشرح زیر می باشد:
قبول (با درجه: عالیامتیاز: ۱۹.....) دفاع مجدد مردود

۱- عالی (۲۰-۱۸)

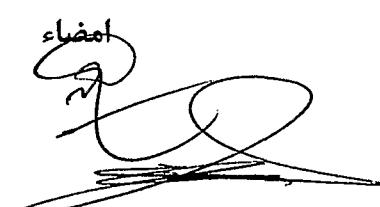
۲- بسیار خوب (۱۶-۱۷/۹۹)

۳- خوب (۱۵-۱۴/۹۹)

۴- قابل قبول (۱۳-۱۲/۹۹)

عضو هیأت داوران

۱- استاد راهنمای اول



رتبه علمی

استادیار

نام و نام خانوادگی

دکتر یوسفعلی عابدینی

استادیار

دکتر جواد بداق جمالی

۲- استاد راهنمای دوم

استادیار

دکتر سیامک خادمی

۳- استاد ممتحن داخلی

استادیار

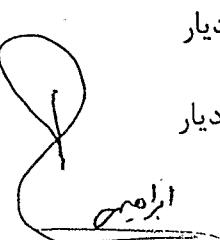
دکتر سهیلا جوانمرد

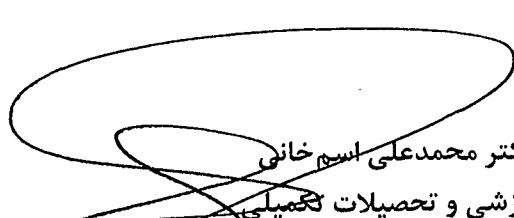
۴- استاد ممتحن خارجی

استادیار

دکتر محمد ابراهیمی

۵- نماینده تحصیلات تکمیلی





۸۴۱

دکتر محمدعلی اسماعلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشکده علوم

تقدیم به پدر عزیز و

مادر فد اکارم

که در نهایت دلسوزی همیشه و در همه حال
پشتیبان من بودند و این امنیت آغوششان بود که
پیشرفت مرا در زندگی موجب شد.

قدرتانی و تشکر

سپاس خداوند مهربان را که دیگر بار مرا در مسیر یادگیری دانش قرار داد.

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر جمالی که همواره از نظر علمی و فکری راهنمای و پیشوای من بودند و خدمات بسیاری متحمل شدند سپاسگزارم.

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عابدینی به خاطر دلسوزی‌ها و خدماتشان سپاسگزارم.
از داوران گرامی جناب آقای دکتر خادمی و سرکار خانم دکتر جوانمرد که زحمت مطالعه و
داوری پایان نامه را قبول نمودند سپاسگزارم.

چکیده

سیستم های رادیکال آزاد آلی با اسپین توزیع شده روی تمام اتم ها (اسپین غیرمتمرکز) ، بخاطر وجود الکترون جفت نشده در ساختارشان دارای خاصیت مغناطیسی بوده و می توان تنوعی از رفتارهای مغناطیسی را بصورت آنتی فرومغناطیس (AFM) ، فرومغناطیس (FM) ، اسپین - پایرلز، فری مغناطیس و پارامغناطیس بعلت تنوع آرایش اسپینی در مولکولها مشاهده نمود. هامیلتونی اسپینی منطبق شده برای برهم کنش تبادلی در این سیستم ها از نوع هامیلتونی تبادلی هایزنبرگ است. برای بررسی این رفتارهای مغناطیسی ، اندازه گیری های پذیرفتاری مغناطیسی روی نمونه های پودری و کریستالی این رادیکال ها لازم است که برای این تحقیق از نتایج بدست آمده در آزمایشگاه های دمای پایین دانشگاه کیوشو ژاپن استفاده شده است.

براساس این نتایج در سیستم های رادیکالی از طریق رسم منحنی های پذیرفتاری مغناطیسی بر حسب دما از دماهای بسیار پایین در حدود $4K$ تا دماهای بالا در حدود $300K$ و مطابقت این رفتارهای مغناطیسی مشاهده شده با مدل های نظری موجود می توان نوع برهم کنش تبادلی موجود بین اسپین ها را تشخیص داد که این برهم کنش تبادلی در اغلب موارد بصورت AFM و FM می باشد. البته در بعضی از این سیستم ها می توان رفتارهای مغناطیسی خاصی را مثلا بصورت اسپین - پایرلز و یا فرومغناطیس ضعیف مشاهده نمود. در ضمن با استفاده از این اندازه گیری ها تأثیر ناخالصی های غیرمغناطیسی روی این سیستم های رادیکالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست

صفحه	عنوان
پنجم	چکیده
۴	مقدمه
۱	۱ اصول و مبانی رفتار مغناطیسی مواد
۲	۱.۱ مقدمه
۵	۲.۱ منشأ مغناطیس در ماده
۵	۱۰.۱ مقادیر گشتاورهای مغناطیسی اتمی
۶	۳.۱ خواص مغناطیسی جامدات
۸	۱۰.۲ دیامغناطیس و پارامغناطیس
۱۱	۲.۳.۱ محاسبه مغناطیدگی بعنوان تابعی از دما
۱۲	۳.۳.۱ فرومغناطیس
۱۴	۴.۳.۱ منشأ فیزیکی مواد فرومغناطیس
۱۷	۵.۳.۱ فری مغناطیس و آنتی فرومغناطیس
۱۹	۴.۱ پسماند مغناطیسی
	۰.۱ وابستگی دمایی مواد مغناطیسی

عنوان

صفحه

۲ برهم کنش های مغناطیسی در جامدات	۲
۱.۲ مقدمه.....	۲۲
۲.۱ برهم کنش ها و جفت شدگی های مغناطیسی.....	۲۳
۲.۱.۲ جفت شدگی میدان مغناطیسی در راستای محور Zها.....	۲۳
۲.۱.۲.۲ برهم کنش اتصالی.....	۲۴
۲.۱.۲.۲.۲ جفت شدگی اسپین الکترونی با میدان های مغناطیسی داخلی و خارجی.....	۲۵
۲.۱.۲.۲.۳ برهم کنش تبادلی الکترونی.....	۲۷
۲.۱.۲.۲.۴ هامیلتونی هایزنبرگ.....	۲۸
۳ روش های تجربی پژوهش در خواص مغناطیسی جامدات	۳
۳.۱ مقدمه.....	۳۵
۳.۲ تأمین داده های موردنیاز تحقیق از طریق آزمایش های تجربی.....	۳۶
۳.۲.۱ اندازه گیری های مغناطیسی انجام شده	۳۸
۳.۲.۲ انواع روش های اندازه گیری مغناطیسی.....	۴۰
۳.۲.۲.۱ روش مغناطوسنجی SQUID	۴۱
۳.۲.۲.۲ تکنیک های مغناطوسنجی DC و AC	۶۱
۳.۲.۲.۳ تکنیک تشدید پارامغناطیسی الکترون (EPR)	۷۳

عنوان

صفحه

۴.۳.۳ تکنیک پراش سنجی نوترونی ۸۲

۴ رفتار مغناطیسی رادیکال های آزاد آلی

۱.۴ مقدمه ۱۰۰

۲.۴ رادیکال های آزاد آلی ۱۰۲

۳.۴ رادیکال های وردازیل ۱۰۴

۴.۴ خواص مغناطیسی رادیکال ها ۱۰۷

۵.۴ ساختار الکترونی رادیکال های وردازیل ۱۱۰

۶.۴ تحلیل داده های آزمایشگاهی ۱۱۲

۱.۶.۴ سیستم های Spin – Peierls ۱۱۸

۲.۶.۴ تأثیر ناخالصی های غیرمغناطیسی روی سیستم های رادیکالی ۱۲۰

۰ شرح نتایج و جمع بندی

پیوست ۱۳۴

مراجع ۱۴۱

مقدمه

فیزیک حالت جامد به شاخه های بسیار متنوعی تقسیم می شود که در آنها به جنبه های گوناگونی از خواص مواد جامد پرداخته می شود. یکی از این شاخه ها مغناطیس است که دارای موقعیت بارز و شناخته شده ای می باشد.

علم مغناطیس از این مشاهده که برخی سنگها (سنگهایی که بطور طبیعی مغناطیسند) مانند آهنرباها رفتار می کردند سرچشمه گرفت. وقتی یونانیان و چینیهای عهد باستان این سنگهای کمیاب را کشف کردند، آنها از توانایی این سنگها در جذب فلز از فاصله های کم در تعجب بودند. خیلی بعد آنها یاد گرفتند که از این سنگهای مغناطیسی در قطب نما برای تعیین جهت استفاده کنند [۲]. امروزه آهنرباها و مواد مغناطیسی همه جا حضور دارند. آنها را در VCR^۱ها، نوارهای صوتی، ATM^۲ و کارتھای اعتباری، گوشی های صوتی و حتی در جوهری که برای چاپ اسکناس بکار می رود می توانیم بینیم. مهمتر از این صنایع الکترونیکی جدیدی هستند که می شناسیم (شامل حوزه های موسیقی، اطلاعات و ساخت حافظه های مغناطیسی) که نمی توانند بدون مواد مغناطیسی وجود داشته باشند.

تنوع خواص مغناطیسی در گونه های مختلفی از مواد نشان داده می شود و امکان تحقیقات تجربی گسترده ای را به تشابه موضوعات نظری فراهم می کند. برای اینکه ماده ای مغناطیسی باشد، باید اتم های آن دارای گشتاور مغناطیسی باشند که گشتاور اتم آزاد معمولاً دارای سه منشأ اساسی است: اسپین الکترون ها، اندازه حرکت زاویه ای مداری الکترون ها به گرد هسته و

^۱ Video Casset Recorder
^۲ Automatic Teller Machine

تغییری که میدان مغناطیسی خارجی در گشتاور مداری القا می کند. (البته لازم به یادآوری است که هسته اتم هم دارای اسپین می باشد؛ اما چون هسته نسبت به الکترون دارای جرم بیشتری است هیچ سهمی در گشتاور مغناطیسی اتم ندارد). اتم هایی که پوسته های الکترونی آنها پر است دارای گشتاورهای اسپینی و مداری صفر هستند: درواقع گشتاورهای مغناطیسی به پوسته های پر نشده مربوط می شوند.

آرایش متنوع اسپین ها در ماده بصورت اتم و یا یون تنوعی از رفتارهای مغناطیسی شامل پارامغناطیس، دیامغناطیس، فرومغناطیس، آنتی فرومغناطیس، اثرمیزرن (دیامغناطیس کامل) و را نمایش می دهند. در این بین سیستمی که دارای الکترون جفت نشده باشد بخوبی می تواند بیانگر نظم مغناطیسی باشد . از جمله این سیستم ها ، سیستم های رادیکالی هستند که بارزترین مشخصه آنها وجود الکترون جفت نشده در ساختار مولکولی می باشد. در ترکیبات آلی گشتاورهای مغناطیسی از یک الکترون $2p$ جفت نشده در اریتال مولکولی سرچشمه می گیرند و شامل سیستم های اسپینی جایگزینه و غیرجایگزینه می شوند [۲۳]. از این رو خواص مغناطیسی چنین ترکیباتی طبیعت منحصر به فردی را در مقایسه با مواد مغناطیسی معمولی نشان می دهند. بدلیل وجود الکترون جفت نشده در ساختار رادیکال آزاد آلی ، این ترکیبات ناپایدار می باشند اما در این بین رادیکال هایی که دارای حلقه بنزن باشند بدلیل وجود رزونانس در ساختارشان ، پایداری آنها افزایش می یابد. از جمله رادیکال های آزاد آلی پایدار ، رادیکال های وردازیل^۳ می باشند که شامل چهار هسته نیتروژن در یک حلقه بنزن می شوند. اما نکته بسیار مهم این می باشد که اسپین الکترون آزاد نه تنها دارای رزونانس (تشدید) برروی حلقه بنزن (دراینجا شامل چهار

اتم نیتروژن) می باشد ، بلکه این اسپین بروی تمام اتم های رادیکال توزیع می شود. در بعضی اتم ها چگالی اسپین توزیع شده بالا بوده و در بعضی بسیار ضعیف می باشد و مهم تر اینکه علامت جهت گیری اسپین بروی همه اتم های یک رادیکال یکسان نبوده و بصورت مثبت و منفی (بالا و پایین) توزیع می شود.

یکی از نکات مهم در زمینه رفتارهای مغناطیسی مواد و برهم کنش های موجود در آنها این است که بزرگی برهم کنش مغناطیسی در مقایسه با بزرگی برهم کنش الکتروستاتیکی بسیار کوچک بوده و لذا عامل اصلی در برهم کنش های تبادلی بین اسپین ها از نوع الکتروستاتیک بین الکترون های همسایه می باشد [۲]. برهم کنش های تبادلی برای پی بردن به برهم کنش های مغناطیسی در جامدات دارای اهمیت اساسی می باشند که از برهم کنش الکتروستاتیکی و اصل طرد پائولی سرچشمه می گیرند.

در زمینه مطالعه خواص مغناطیسی مواد کارهای تجربی صورت گرفته در این زمینه از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشند [۲۳]. البته آزمایشگاه های موردنیاز برای حاصل شدن این داده های تجربی باید دارای شرایط خاصی باشند ؛ از جمله اینکه در این آزمایشگاه ها باید بتوان داده های مغناطیسی موردنیاز را در دماهای بسیار پایین حتی تا 4mK بدست آورد ؛ البته تعداد این آزمایشگاه ها در دنیا تا اندازه ای محدود هستند. از جمله دستگاه های اندازه گیری مغناطیسی با دقت بسیار بالا ، مغناطیسی سنج SQUID می باشد . چراکه این دستگاه قادر است در دماهای بسیار پایین تا دماهای بالا در حدود 300K با بهره گیری از حلقه های ابررسانا میدان های مغناطیسی را به کوچکی T^{-15} اندازه گیری کند.

در این تحقیق اندازه گیری خواص مغناطیسی مربوط به سیستم های رادیکالی مورد استفاده هم در دماهای بسیار پایین و هم در میدان های مغناطیسی قوی و ضعیف با استفاده از این دستگاه در آزمایشگاه های دمای پایین دانشگاه کیوشو ژاپن انجام گرفته اند.

در تحقیقاتی که روی این رادیکال های وردازیل انجام گرفته ، نمونه پودری این رادیکال های آزاد بصورت خالص و آلایده شده با ناخاصی های غیرمغناطیسی ، مورد استفاده قرار گرفته اند و پذیرفتاری مغناطیسی و مغناطیدگی از دمای اتاق ، $300K$ ، تا دمای $4K$ تحت میدان مغناطیسی $200G$ مورد اندازه گیری قرار گرفته اند. معمولاً تحلیل رفتار مغناطیسی این رادیکال ها از طریق داده های پذیرفتاری مغناطیسی بر حسب دما صورت می گیرند و از روی منحنی های بدست آمده مثلاً می توان به نوع برهم کنش های موجود در این سیستم های رادیکالی بصورت آنتی فرومغناطیسی (AFM) ، فرمغناطیسی (FM) و فرمغناطیسی ضعیف (WFM) ، پی برد. البته براساس مدل های تنوری موجود ، داده های تجربی مواد مورد تحلیل و برآش قرار گرفته و میزان بزرگی و نوع برهم کنش مغناطیسی بین اسپین های همسایه و غیر همسایه را تعیین می کنیم . در این مدل هامیلتونی برهم کنش تبادلی خطی هایزنبرگی (تصورت یکنواخت و نامتقارن) با داده های تجربی سازگاری و تطابق نشان داده است. در ضمن از طریق طرح های پراش اشعه - X اندازه گیری شده روی نمونه های پودری این رادیکال ها نیز می توان به تحلیل ساختارهای کریستالی این نمونه ها پرداخت.

این پایان نامه شامل پنج فصل می شود که در فصل های اول و دوم مباحث نظری مربوط به مغناطیس ارائه شده است. در فصل سوم به روش های تجربی در مغناطیس از جمله انواع روش

های اندازه گیری خواص مغناطیسی پرداخته شده است. در فصل چهارم که در واقع بخش اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد براساس دانش کسب شده در طول تحقیق و شناخت حاصل شده از نحوه برهم کش مواد مغناطیسی ، ما به تحلیل رفتار مغناطیسی این سیستم ها می پردازیم. در فصل پنجم هم به شرح نتایج حاصله از این تحقیق اشاره می شود. درختمه امید است این پژوهش قدمی هرچند کوچک در راستای توسعه علم مغناطیس در بین دانشجویان و محققین کشور باشد.

فصل اول

اصول و مبانی رفتار مغناطیسی مواد

۱۰۱ مقدمه

در فیزیک حالت جامد، مبحث مغناطیس موقعیت بارزی را دارا می باشد. تنوع خواص مغناطیسی در گونه های مختلفی از مواد نشان داده می شود و امکان تحقیقات تجربی گسترده ای را به تشابه موضوعات نظری فراهم می کند. از سوی دیگر کاربردهای عملی مغناطیس دارای اهمیت تجاری و تکنیکی زیادی می باشند.

خواص مغناطیسی مواد از خواص اسپینی الکترون ها سرچشمه می گیرند چراکه هر الکترونی دارای خاصیت اسپین است. از طرفی چون الکترون باردار بوده و دارای حرکت می باشد، یک میدان مغناطیسی را ایجاد می کند و این شبیه به ایجاد میدان مغناطیسی بوسیله جریان الکترونی از یک سیم حلقه ای می باشد. درواقع این تغییر میدان الکتریکی است که منجر به یک میدان مغناطیسی می شود. آرایش متنوع اسپین ها در ماده بصورت اتم و یا یون تنوعی از خواص مغناطیسی شامل پارامغناطیس، دیامغناطیس، فرومغناطیس، آنتی فرومغناطیس، اثرمیزner(دیامغناطیس کامل) و را نمایش می دهند. اما در حالت کلی اغلب مواد هیچ پاسخ

بدیهی به یک میدان مغناطیسی اعمال شده ندارند و این بدین خاطر است که اریتال های الکترونی اتم ها با جفت های الکترونی هریک با اسپین مخالف، پر می شوند؛ به همین دلیل ترتیب الکترون ها در اریتال های یکسان، منجر به لغو گشتاورهای مغناطیسی می شوند. با توجه به موضوع پایان نامه که در خصوص خواص مغناطیسی رادیکال های آزاد می باشد، در این فصل خواص مغناطیسی مواد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

۲.۱ منشأ مغناطیس در ماده

برای اینکه میدان مغناطیسی بر روی ماده ای تأثیر فوق العاده ای داشته باشد، باید حداقل یک گروه از اتم های داخل آن مانند آهرباهای کوچک رفتار کنند؛ یعنی اینکه باید دارای گشتاور مغناطیسی باشند؛ علاوه بر این از نقطه نظر مغناطیسی توصیفی از یک ماده جامد شامل تعیین جهت گشتاور مغناطیسی در هر نقطه از شبکه می باشد که این جهت ممکن است از هر اتم به اتم دیگر تغییر کند [۱].

گشتاور مغناطیسی مربوط به ساختار الکترونی اتم بوده و می تواند بصورت زیر معرفی شود:

۱- یک الکtron چه بصورت آزاد یا مقید به یک اتم، دارای اسپین $\frac{1}{2}$ بوده و یک گشتاور زاویه

ای ذاتی دارد که فقط شامل دو مقدار $\frac{\hbar}{2}$ و $-\frac{\hbar}{2}$ می باشد؛ که

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054 \times 10^{-34} Js \quad . \quad (1.1)$$

این گشتاور زاویه ای به الکtron یک گشتاور مغناطیسی می دهد که بزرگی آن به عنوان مگنتون

بوهر شناخته می شود :

¹ Bohr magneton

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} Am^2 . \quad (2.1)$$

گشتاور مغناطیسی الکترون می تواند دو مقدار $\mu_B +$ و $\mu_B -$ را بگیرد که وابسته به جهت الکترون است. البته برای هسته اتم هم می توان این گشتاور مغناطیسی را در نظر گرفت اما مقدار آن در مقایسه با گشتاور مغناطیسی الکترون (با توجه به بزرگ بودن جرم هسته های اتم در مقایسه با جرم الکترون) کوچک بوده و قابل صرفنظر کردن است.

-۲- الکترون اتم از راه دیگری هم می تواند در گشتاور مغناطیسی اتم مشارکت داشته باشد. در حرکت الکترون بدور هسته ، الکترون یک میدان مغناطیسی خلق می کند . پس گشتاور مغناطیسی در اینجا وابسته به گشتاور زاویه ای اربیتالی الکترون است. گشتاور مغناطیسی برابر می شود با :

$$\mu = m\mu_B , \quad (3.1)$$

که m عدد کوانتومی مغناطیسی است. البته این گشتاور مغناطیسی را می توان بصورت کلاسیکی هم محاسبه کرد: اگر فرض کنیم مداری که الکترون بدور آن در حال حرکت است بصورت دایره ای بوده و الکترون با جرم m_e در نقطه \vec{R} در فضا قرار گرفته باشد و با سرعت v بدور یک مرکز ثابت در حال حرکت باشد، در اینصورت گشتاور زاویه ای برابر می شود با:

$$J = \vec{R} \times m_e \vec{v} = m_e R v \hat{n} , \quad (4.1)$$

که \vec{R} شعاع مدار و \hat{n} بردار عمود بر صفحه مدار است. الکترون چرخنده معادل با یک حلقه حامل جریان است که جریان آن برابر می شود با :

$$I = \frac{-e}{t} = \frac{-e}{2\pi R} = \frac{-ev}{2\pi R} . \quad (5.1)$$

در اینصورت برای گشتاور مغناطیسی اتم داریم:

$$\mu = Is \hat{n} = -\left(\frac{e v}{2\pi R}\right)\pi R^2 \hat{n} = \frac{-1}{2}evR \hat{n} \quad (6.1)$$

از طرفی می توان گشتاور مغناطیسی را بصورت زیر هم نوشت:

$$\mu = \frac{-e}{2m_e} m_e R v \hat{n} = \gamma J, \quad (7.1)$$

که کمیت γ نسبت ژیرومغناطیسی مریبوط به الکترون است:

$$\gamma = \frac{-e}{2m_e}. \quad (8.1)$$

اگر $J = m\hbar$ در اینصورت:

$$\mu = -m \left(\frac{e\hbar}{2m_e} \right) = -m \mu_B. \quad (9.1)$$

بنابراین گشتاور مغناطیسی اریتالی و اسپینی الکترون هر دو شامل کمیت بنیادی μ_B هستند. در

واقع برای گشتاورهای اریتالی و اسپینی می توان نوشت:

$$\mu = g \mu_B J / \hbar, \quad (10.1)$$

عامل g برای سهم اریتالی برابر با ۱ و برای سهم اسپینی برابر با ۲ است.

بنابراین گشتاور مغناطیسی یک اتم بصورت مجموع دو اثر می باشد: یکی ناشی از حرکت مداری

الکترون و دیگری ناشی از اسپین و در حالت کلی داریم:

$$\mu = g \mu_B J, \quad (11.1)$$

که g عامل g لاند می باشد. اگر فقط گشتاورهای اسپینی سهیم باشند، g برابر با ۲ و اگر

گشتاورهای اریتالی سهیم باشند، g برابر با ۱ بوده و اگر هردو سهیم باشند، g بین ۱ و ۲ قرار می گیرد.

^۲ Gyromagnetic ratio

^۳ Lande g-factor

۱.۰۲.۱ مقادیر گشتاورهای مغناطیسی اتمی

برای اتم آزاد:

برطبق اصل پائولی فقط دو الکترون با اسپین های مخالف می توانند در یک اریتال قرار گیرند. وقتی اریتال پر باشد گشتاور زاویه ای کل ناشی از اسپین های الکترونی جفت نشده صفر است. بنابراین پوسته ای که بطور کامل پر شده باشد، هیچ سهمی در گشتاور مغناطیسی اتم ندارد. در یک اتم با الکترون های زیاد، اغلب الکترون ها در پوسته های کامل داخلی قرار گرفته اند و هیچ سهمی در گشتاور مغناطیسی ندارند. به همین خاطر است که اندازه گشتاورهای مغناطیسی اتمی همیشه دارای یک مقدار کوچکی برابر با یک عدد کوچک مگتون بوهر می باشند.

برای اتم در یک جامد:

یون های تشکیل دهنده یک جامد دارای ابر الکترونی هستند که در اطراف هسته قرار گرفته اند و در پوسته ای که بطور کامل پر شده باشد، پایان می یابند. بنابراین اگر آنها دارای یک پوسته داخلی کاملاً پر نشده باشند، گشتاور مغناطیسی غیر صفر دارند.

۱.۳ خواص مغناطیسی جامدات

مواد مغناطیسی براساس نحوه پاسخ به میدان های مغناطیسی خارجی طبقه بندی می شوند بصورت: دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس، فری مغناطیس و....؛ دیامغناطیس خاصیتی مربوط به تمام مواد بوده و با میدان مغناطیسی اعمال شده مخالفت می کند اما این خاصیت بسیار